

ПРОТОКОЛ № 2/2016
Заседания Конкурсной Комиссии
на замещение вакантных должностей научных работников
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники
Российской академии наук

г. Москва

27 декабря 2016 г.

Присутствовали:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Председатель комиссии | - доктор технических наук, профессор, директор ИСВЧПЭ РАН С.А.Гамкрелидзе |
| Заместитель председателя комиссии | - кандидат физико-математических наук, заместитель директора по научной работе ИСВЧПЭ РАН Д.С. Пономарев |
| Секретарь комиссии | - кандидат физико-математических наук, ученый секретарь ИСВЧПЭ РАН Р.А. Хабибуллин |
| Члены комиссии: | - кандидат технических наук, председатель Профкома ИСВЧПЭ РАН А.Ю. Павлов |
| | - доктор технических наук, профессор, зам. ген. директора по научной работе ОАО «НПП «Пульсар» Ю.В.Колковский |
| | - член-корреспондент РАН, врио директора ФТИАН В.Ф. Лукичев |
| | - доктор технических наук, профессор, зам. директора НИИВТ им С.А. Векшинского С.Б. Нестеров |

Всего: 7 человек из 7 членов Конкурсной комиссии.

Повестка дня:

- 1) Проведение конкурса на замещение вакантной должности младшего научного сотрудника лаборатории №104 «Лаборатория исследований и разработок методов моделирования и проектирования наногетероструктурных СВЧ- транзисторов и МИС, и исследования их характеристик в см- и мм-диапазонах».

Слушали:

Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., проф. С.А.Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, в Конкурсную комиссию ИСВЧПЭ РАН поступило заявление и комплект документов, необходимых для проведения конкурса от Крапухина Дмитрия Владимировича для избрания его на должность младшего научного сотрудника лаборатории исследований и разработок методов моделирования и проектирования наногетероструктурных СВЧ- транзисторов и МИС, и исследования их характеристик в см- и мм-диапазонах.

Он зачитал характеристику Крапухина Д.В., подписанную заведующим лабораторией №104 Гнатюком Д.Л.. В ней, в частности отмечается, что в период с 2012 по 2016 г. обучался в аспирантуре МГУ (МИРЭА) по специальности 05.27.01 “Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нано-электроника, приборы на квантовых эффектах”.

Крапухин Д.В. является соавтором более 10 статей в ведущих отечественных и зарубежных научных журналах, одного свидетельства на топологию интегральной микросхемы, принимал участие в написании монографии. Результаты исследований неоднократно представлялись лично Крапухиным Д.В. на отечественных и международных научных конференциях. В процессе работы в ИСВЧПЭ РАН он проявил себя квалифицированным специалистом в области проектирования и моделирования МИС, способным к самостоятельной научно-исследовательской работе.

Документы удовлетворяют квалификационным характеристикам. Больше заявок на занятие этой должности в Конкурсную комиссию не поступало.

Постановили:

По 1-му пункту повестки дня:

1) Согласно п. 11 Приложения №2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 г. №937 в продлении срока рассмотрения заявок для проведения собеседования с претендентом необходимости нет.

2) Признать конкурс на замещение вакантной должности младшего научного сотрудника лаборатории №104 «Лаборатория исследований и разработок методов моделирования и проектирования наногетероструктурных СВЧ- транзисторов и МИС, и исследования их характеристик в см- и мм-диапазонах» состоявшимся в объявленные сроки.

3) Согласно п. 12 Приложения №2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 г. №937 по итогам рассмотрения заявки Конкурсная комиссия составила рейтинг претендента на основании балльной оценки, выставленной членами Конкурсной комиссии претенденту, исходя из сведений содержащихся в заявке и иных прикреплённых к заявке материалах, которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента, Конкурсная комиссия приняла решение избрать на должность:

- младшего научного сотрудника лаборатории исследований и разработок методов моделирования и проектирования наногетероструктурных СВЧ- транзисторов и МИС, и исследования их характеристик в см- и мм-диапазонах Крапухина Дмитрия Владимировича.

Председатель Конкурсной комиссии
д.т.н., профессор



С.А. Гамквелидзе

Секретарь Конкурсной комиссии
к.ф.-м.н.



Р.А. Хабибуллин

«27» декабря 2016 г.